

热点

7月16日,国内DRAM(动态随机存取存储器)一体化龙头长鑫科技将开启新股申购,发行价为8.66元/股。长鑫科技登陆科创板,不仅是单一企业的资本化里程碑,更是国产半导体产业链成熟度提升的重要信号。

长期以来,全球DRAM存储芯片市场被海外巨头垄断,核心技术、量产能力和市场话语权牢牢掌握在境外企业手中。长鑫科技走了十年,在重资产、长周期、高迭代、强研发的存储芯片领域用自己的节奏,一步步站上了中国第一、全球第四位置,打破了三星、SK海力士、美光三家海外企业的长期寡头垄断格局。

长鑫科技的上市,标志我国DRAM产业从技术验证爬坡阶段,正式进入规模化扩产、全产业链协同发展新阶段,对上游设备材料、中游制造封测、下游算力终端形成全方位拉动效应。

■新快报记者 涂波

募资295亿元! 2026年A股最大融资项目、科创板史上第二IPO

“十年一剑”打破海外垄断 长鑫科技IPO背后 国产半导体产业的跃迁

十年磨一剑

差异化战略实现“换道超车”

长鑫科技成立于2016年,总部位于安徽合肥,是中国规模第一、布局最全的动态随机存取存储器(DRAM)研发设计制造一体化企业,采用IDM(垂直整合制造)业务模式。

在技术上,长鑫科技采取差异化“跳代研发+换道超车”战略,依托DUV深紫外光刻实现高密度存储制造,绕开EUV光刻机管制壁垒。同时布局后HBM时代全新技术赛道,规避与韩企在传统制程上的正面竞争。

招股书显示,长鑫科技目前已商业化量产的DDR4、LPDDR4X和LPDDR5系列内存芯片及模组,已成功应用于小米、OPPO、vivo、传音等国内主流智能手机品牌机型中,服务器DDR5批量供货阿里云、腾讯云、浪潮信息,切入国内AI算力核心供应链。

公司已建成合肥、北京三座12英寸晶圆工厂,当前月产能28万-30万片,产能利用率常年稳定95%以上。据Omdia行业统计数据,目前长鑫科技的DRAM产能、出货量、销售额均位列中国第一、全球第四,打破了三星、SK海力士、美光三家海外企业的长期寡头垄断格局。长鑫科技的崛起,标志着中国在DRAM领域实现了从0到1的突破,有望逐步提升市场份额。

本次IPO,长鑫科技拟募资295亿元。募资完成后,企业将加速扩产,2026年底产能提升至35万片/月,2028年目标月产50万片,持续缩小与海外三巨头产能差距。

中信证券半导体行业分析师王博表示,长鑫本次IPO完成战略闭环,此前持续亏损的核心约束是资本开支压力,大规模募资将打通产能扩张、高端研发资金瓶颈,差异化技术路线让国内存储产业摆脱跟随式研发,真正建立自主技术护城河。

重构估值逻辑

科创板是上交所专门服务“硬科技”企业的独立板块,主要支持符合国家战略、突破关键核心技术的公司上市。长鑫科技本次IPO,不仅是2026年A股最大融资项目,也是科创板史上第二大IPO,仅次于中芯国际532亿元的募资规模。市场分析认为,长鑫科技的上市将充当科技股的“价值锚点”,会让AI的估值逻辑从“讲故事”转向“看业绩”。

拉动全链国产替代

世界半导体贸易统计组织(WSTS)预测,2026年全球半导体市场规模将增长逾25%,达到9750亿美元,其中存储芯片与逻辑芯片有望再次领跑市场,同比增幅均超30%。而中国集成电路产业自给率仍处于较低水平,2022年仅为18.3%,在存储芯片等核心领域存在巨大的国产替代空间。

长鑫科技上市,标志我国DRAM产业从技术验证爬坡阶段,正式进入规模化扩产、全产业链协同发展新阶段,对上游设备材料、中游制造封测、下游算力终端形成全方位拉动效应。

最广泛的造富

本次长鑫科技IPO,创造了A股半导体史上规模最大的财富分配窗口,覆盖地方国资、国家级产业基金、保险、券商和核心研发员工等主体,将诞生一批深耕硬科技赛道的科技新贵,印证国家长期布局半导体产业的资本回报逻辑。

其中,合肥国资作为最早战略投资方,2016年首期出资144亿元,穿透合计持股36.79%,按3万亿市值中枢测算,对应权益市值超1万亿元,浮盈

或成科技股“价值锚点”

此前,A股半导体板块估值分化明显,设计企业普遍享受高估值溢价,晶圆制造、存储周期类企业因行业周期性亏损,长期维持低市盈率估值,市场对存储制造企业盈利持续性存在质疑。

过去十年中,长鑫科技也经历了漫长的持续大额亏损,直到2025年,依托AI算力催生的存储超级周期,长鑫科技业绩终于迎来“V”字反转,首度实现年度盈利。2026年一季度,其

归母净利润达247.62亿元,上半年预计净利润区间500亿-570亿元,日均盈利接近3亿元,彻底摆脱行业周期低谷。

从连年大额亏损到单日盈利3亿元,长鑫科技的业绩反转将彻底重构存储赛道估值逻辑。2026年一季度,长鑫科技营收508亿元,同比增长719%;归母净利润247.62亿元,同比增长1688%,树立了硬科技企业的业绩标杆。

完善存储产业安全底座

在上游设备与材料端,此前国产半导体设备普遍存在“单机验证难、整线导入慢”痛点,长鑫大规模扩产,将提供长期稳定验证场景,推动国产设备从“可用”向“好用”跨越,解决存储制造设备卡脖子难题,持续提升国产设备导入比例,刻蚀、薄膜、清洗核心设备国产化率。在中游封测环节,本土封测企业依托长鑫订单优化高端存储封装工艺,补齐国内算力存储封装短板。在下游产业链层面,AI服务器、消费电子、新能源汽车厂商大幅降低海外存储采购依赖。

市场研究机构Counterpoint数据

显示,2026年一季度长鑫科技手机DRAM市场份额为19.1%,仅落后美光0.6个百分点;国内云厂商国产DRAM采购比例从2024年不足8%提升至2026年26%,供应链安全韧性显著增强。

工信部电子信息司相关专家表示,存储芯片是数字经济、人工智能底层核心基础元器件,此前国内DRAM完全依赖进口,长鑫规模化量产与资本化,补齐集成电路产业最大短板,与长江存储形成“DRAM+NAND”国产存储双雄格局,落实“十五五”集成电路全产业链自主可控战略目标。

体现资本回报逻辑

规模接近合肥市2025年全年GDP一半,地方政府十年耐心资本投入获得超额回报。

此外,研发人才成为核心受益群体。公司推出两期员工持股计划,累计覆盖6760名员工,研发人员占比超三成,授予价格低至0.108元/注册资本,上市后股权价值大幅提升,有望成为A股史上最广泛的造富运动。

长鑫科技董事长朱一明公开承诺,上市36个月后将名下7.68亿股股

份无偿分配给在职员工,构建长期绑定的人才激励机制,打造国内半导体行业规模最大的科研人才造富平台。

资本市场业内人士指出,长鑫的造富效应将形成正向示范,引导社会长期资本、高端人才持续流入集成电路硬科技赛道,改变此前资本扎堆互联网、消费赛道的格局,完善国内硬科技投融资生态,为后续芯片制造、先进材料企业登陆资本市场打开估值与资金通道。